



Compte Rendu

Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications

Electronique Analogique

TP2: Amplificateur Classe C

2^{eme} Année

Année: 2023 - 2024

Camille Lanfredi Rémi Weidle

1. Introduction

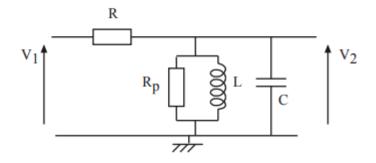
Durant ce TP nous allons concevoir un amplificateur de classe C. Dans un premier temps nous allons déterminer les différents composants pour obtenir un gain de 10.

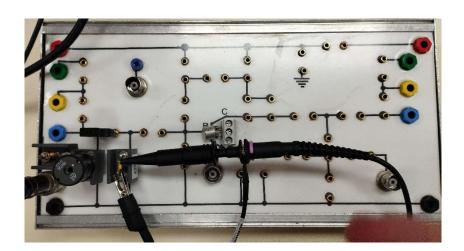
2. Mesures préliminaires

Avant de commencer les différentes mesures, nous nous assurons que le transistor fonctionne correctement. Pour cela, nous utilisons un multimètre pour observer si nous obtenons bien une tension entre la jonction Base-Emetteur et Base-Collecteur. Une fois vérifié, nous pouvons démarrer les manipulations.

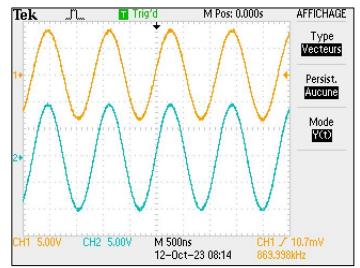
Lors de nos mesures, nous utilisons une sonde d'oscilloscope commutable (x1/x10) car si nous utilisons un oscilloscope avec un simple câble coaxiale, nous ajouterions une capacité entre 100 et 120 pF. L'avantage d'une sonde d'oscilloscope passive est qu'elle réduit cette capacité ramenée d'environ 13 pF.

Pour commencer, nous devons déterminer les valeurs de L et R_p.



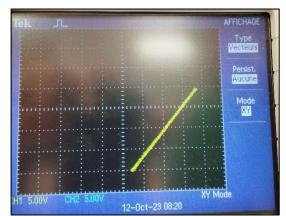


Nous nous plaçons à la fréquence de résonnance $f=f_0$, les impédances réactives L et C se compensent et les tensions d'entrée et de sortie sont en phase. Cependant pour y parvenir nous devons faire varier la fréquence f_0 .



Chronogrammes des signaux d'entrée (jaune) et de sortie(bleu) en phase

En ajustant la fréquence en mode « X/Y », nous obtenons la courbe suivante :



Chronogrammes des signaux d'entrée (jaune) et de sortie(bleu) en mode X/Y

Nous mesurons une fréquence d'oscillation de 865 kHz. Cette valeur st assez proche de celle mesuré précédemment à 870 kHz.

Nous pouvons rappeler ce cela est dû la bobine (inductance) présente dans le circuit et ses phénomènes d'hystérésis du noyau de bobinage. Mais également du transistor qui en haute fréquence présente des effets capacitifs parasites venant de l'émetteur et du collecteur.

Puis, pour déterminer la valeur de la bobine, nous utilisons la relation suivante :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 870kHz$$

$$L = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 * 875.10^6 * 704.10^{-12}} = 41.1\mu H$$

Puis, nous déterminons la résistance de fuite R_P . Cependant nous ne cherchons pas un rapport égal à 0,5 car, dans notre circuit l'amplitude de V2 est de 10V. Le GBF ne peut pas fournir en entrée une amplitude supérieure à 20V. Nous prenons une résistance faible de l'ordre de $1k\Omega$ pour obtenir une tension de V2 de 9V. Donc nous cherchons un rapport de 0,9 car le GBF ne peut pas fournir en entrée une amplitude supérieure à 20V.

La résistance de fuite R_P a pour expression :

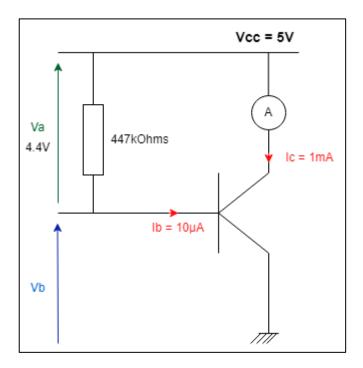
$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{R_p}{R_p + R} = 0.855$$

$$R_p = \frac{0.855 * R}{1 - 0.855} = \frac{0.855 * 1000}{1 - 0.855} = 5896\Omega$$

Nous mesurons la valeur de la capacité avec un banc de test à l'éléments capacitifs.

$$R_p = 703.723pF$$

Et enfin, nous déterminons le β_{statique} . Pour cela, nous réalisons, le schéma équivalent pour un $\beta_{\text{statique}} = 100$ (en théorie).



Donc dans un premier temps, nous mesurons la valeur de I_{CO} qui est de 0,823mA.

Puis, nous déterminons la valeur de IB.

La première solution serait de mesurer directement la tension à ses bornes avec un voltmètre et de la diviser par sa valeur de résistance. Cependant, cette méthode fausse les mesures car si l'on place un voltmètre à ses bornes, sa résistance d'entrée n'est pas infiniment grande devant R_B et ainsi changer le courant de collecteur.

Nous allons donc faire 2 mesures de tension en Va et Vb, faire la différence des 2 et la diviser par la résistance R_B .

$$I_B = \frac{V_A - V_B}{R_B} = \frac{4,469}{447000} = 9,9977 \mu A$$

Avec:

- $V_A = 5,05V$
- $V_B = 0.581$

Nous avons enfin tous les éléments pour déterminer β , grâce à son expression :

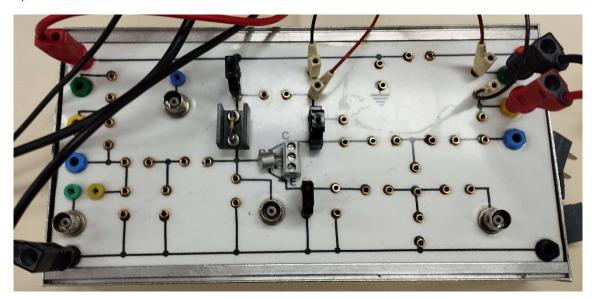
$$I_{c} = \beta I_{B}$$

$$\beta = \frac{I_{C}}{I_{B}} = \frac{0.825mA}{9.9977\mu A} = 82.52$$

$$\beta = 83$$

Travaux pratiques – Electronique Analogique

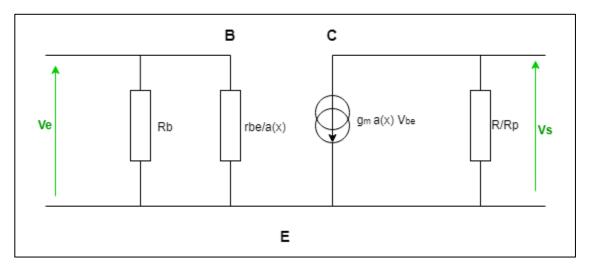
Explication



Montage réalisé sur la maquette

3. Prédétermination des composants du montage

Dans un premier temps, nous réalisons le schéma équivalent en 1^{er} harmonique et en déduire le gain.



Le gain peut alors s'exprime ainsi :

$$G = \frac{V_S}{V_F} = -g_m a(x) * Rc$$

Et $x = \frac{V_{be}}{V_T} = \frac{1}{25.10^{-3}} = 40$ ce qui est très largement supérieur à 1 donc nous pouvons approximer $a(x) = \frac{2}{x} = \frac{1}{20}$.

Donc:

$$g_m = \frac{10}{a(x) * Rc} = 0,076$$

De plus, nous pouvons déterminer I_{CO} à partir de g_m .

$$I_{C0} = g_m * V_T = 1.9mA$$

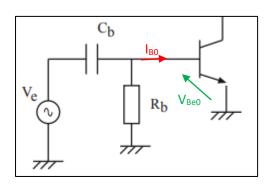
Par extension:

$$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta} = 22.9 \mu A$$

Finalement, nous pouvons déterminer le gain de l'amplificateur,

$$G = -0.076 * \frac{1}{20} * \frac{4.7 * 10^{-3} * 4.58 * 10^{-3}}{4.7 * 10^{-3} + 4.58 * 10^{-3}} = -9.937$$

En polarisation:



$$R_B = \frac{V_{Be0}}{I_{B0}} = \frac{0.3}{69.3 * 10^{-6}} = 13100\Omega$$

Et enfin, nous déterminons la valeur de la capacité C_B à partir de la relation suivante :

$$f_C = \frac{1}{2\pi C_B \left(\frac{R_B * \frac{r_{be}}{a(x)}}{R_B + \frac{r_{be}}{a(x)}}\right)} = 10kHz \ll f_O = 870 \text{ kHz}$$

La fréquence de coupure est fixée à 10kHz pour ne pas influencer la fréquence de fonctionnement du système, qui est de 870kHz.C'est pourquoi nous prenons une valeur largement inférieure.

Puis, nous devons déterminer la valeur de r_{be}. Pour cela, nous utilisons l'expression suivante :

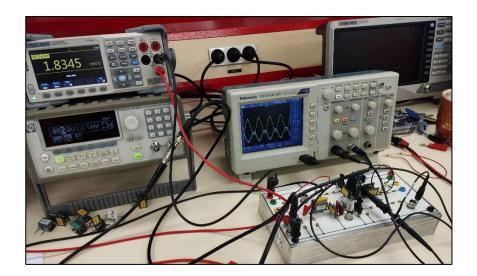
$$r_{be} = \frac{\beta V_T}{I_{C0}} = 1092\Omega$$

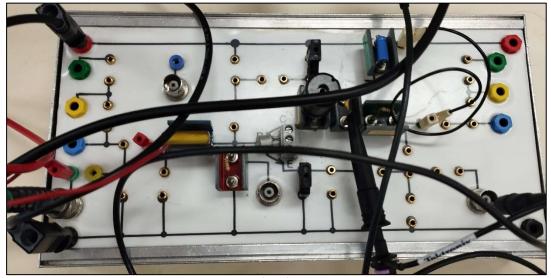
Désormais nous pouvons en déduire la valeur de C_B:

$$C_B = \frac{R_B * \frac{r_{be}}{a(x)}}{2\pi f_C * R_B * \frac{r_{be}}{a(x)}} = 15.9 \mu F$$

4. Expérimentations

Dans un premier temps, nous réalisons le montage de l'énoncé du travail pratique.

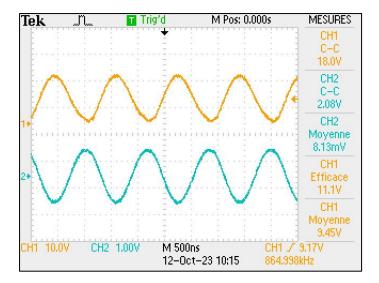




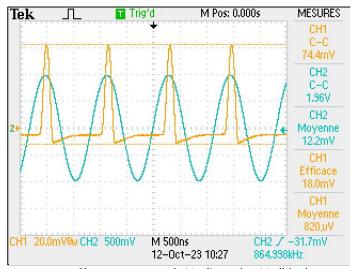
Montage réalisé sur la maquette

Travaux pratiques - Electronique Analogique

Nous obtenons une amplitude de sortie de 18V crête-à-crête soit une amplitude de 9V ce qui quasiment au gain de 10 voulu.

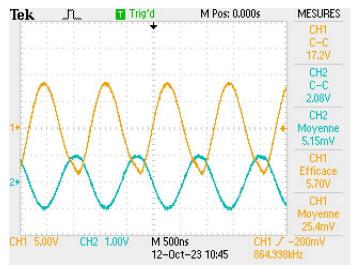


Puis, nous obtenons le chronogramme de Vbe. Celui-ci est identique à Ve avec un léger décalage avec une différence de tension d'environ 0.3V. Ce qui est parfaitement logique car la bobine se décharge lentement.



Chronogrammes de V_{BE} (jaune) et Ve (bleu)

Travaux pratiques – Electronique Analogique



Chronogramme du courant présent dans le collecteur Ic (jaune)

Et enfin, pour obtenir le meilleur rendement, on diminue la valeur de la tension d'alimentation, jusqu'à la limite de la saturation.

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_{charge}}{P_{alim}} = \frac{\frac{U^2}{2R}}{P_{alim}} = \frac{\frac{17,4^2}{2*18000}}{8,6*0,0018} = \frac{0,0086}{0,01548}$$
$$\eta = 55\%$$

5. Simulation

Apres avoir réaliser le schéma sous PSIM, nous obtenons les courbes de la tension et du courant du transistor.

